

平成 29 年 2 月 8 日

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 岸野 克巳

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 98 回委員総会・第 102 回研究会 開催案内
(光電相互変換 第 125 委員会 第 235 回研究会と合同開催)

日時： 平成 29 年 3 月 2 日 (木)

委員総会：12:00 - 12:50

研究会：13:00 - 17:35

意見交換会：17:50 - 19:30

場所： 上智大学四谷キャンパス 12 号館 302 号室

〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1

(JR 四ツ谷駅より徒歩 5 分)

http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya

委員総会

議 題：

- (1) 前回第 97 回委員総会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 103 回研究会以降の研究会について
- (4) ICMOVPE-XIX(2018 年 6 月奈良)への協賛について
- (5) その他

報告事項：

- (1) 2017 年日独西ワークショップ (2017 年 3 月開催予定) について
- (2) IWUMD2017 開催案内
- (3) LEDIA'17 開催案内
- (4) その他

研究会プログラム(案)

主 題： 「紫外発光デバイスの最前線と今後の展開」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(13:00-13:10)

1. 「AlGaIn 系深紫外 LED・LD 開発の最近の動向、国際会議報告などから」(13:10-14:10)
平山 秀樹 (理化学研究所)

2. 「AlGaN 系紫外半導体レーザー開発の進展と応用」(14:10-14:55)

吉田 治正、武富 浩幸、青木 優太、高木 康文、杉山 厚志、桑原 正和、
山下 陽滋、大河原 悟、前田 純也 (浜松ホトニクス株式会社 開発本部)

3. 「AlGaN 混晶半導体の励起子光物性と光機能性」(14:55-15:40)

山田 陽一 (山口大学)

休憩 (15:40-16:00)

4. 「深紫外発光ダイオードの水浄化応用」(16:00-16:45)

小永吉 英典、鳥井 信宏、木内 裕紀、望月 洋明、越智 鉄美、
渡邊 真也 (日機装技研株式会社)

5. 「水銀フリー深紫外面光源の開発と応用状況- Luminous Array Film (LAFi)技術によるプラズマ応用の新展開 -」(16:45-17:30)

栗本 健司 (合同会社 紫光技研)

「委員長挨拶」(17:30-17:35)

(17:50~19:30 意見交換会)

<追記>

1. 3月2日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を2月20日(月)までに日本学術振興会研究事業課 須賀 (jigyouka06@jsps.go.jp)宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 研究会終了後に上智大学2号館5階学生食堂にて、意見交換会を開催いたします。ご出席の際には当日受付で会費2,000円(ご同伴者も2,000円)をお支払ください。